

典型应用:

- 输入信号整形
- 总线驱动

主要指标:

- 输入输出电平0V/5V
- 静态电流小于1 μ A
- 开关时间(典型) $t_{pd}=6ns$
- 最高输入频率40MHz
- 芯片封装: $3\times 3\times 0.75mm$

产品简介:

八线缓冲驱动器芯片, 采用 CMOS 工艺, 逻辑功能与 54/74HCT244 一致, 该芯片内含八个具有三态输出的缓冲器, 两个输出允许控制 (ENA_N、ENB_N), 分别控制四个缓冲器。所有输入和输出均有内部保护线路, 以减小由于静电感应而损坏器件的可能性, 具有高抗噪声度和驱动负载的能力。没有信号输入时, 使能端 ENA_N、ENB_N 默认为高电平, 输入端 A<1:8>, 默认为低电平。

电参数

序号	参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位	说明
1	静态电流	I_{dd}	-	-	1	μA	-
2	驱动电流	I_o	-	3	-	mA	与负载有关
3	输入电流	I_{in}	-	-	1	μA	
4	输出高电平电压	V_{oh}	-	5	-	V	
5	输出低电平电压	V_{ol}	-	0	-	V	
6	开关时间	t_{pd}	-	6	-	ns	F=40MHz, 输入电平的 50% 到输出电平的 50%
7	上升、下降时间	t_{td}	-	6	-	ns	F=40MHz, 输出电平的 10% 到输出电平的 90%

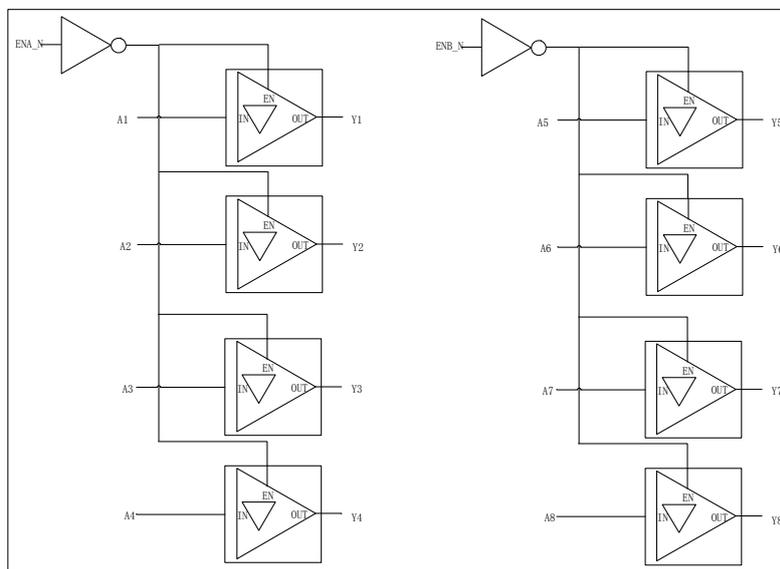
极限条件

项 目	符号	数 值		单位
		最小	最大	
电源电压	V_{DD}	-0.5	6	V
输入电压	V_{in}	-0.5	$V_{DD}+0.5$	V
驱动电流	I_o	-	10	mA
储存温度	T_s	-65	+150	°C

推荐工作条件

项目	符号	规范值		单位
		最小	最大	
电源电压	V_{DD}	4.5	5.5	V
输入高电平电压	V_{ih}	3	-	V
输入低电平电压	V_{il}	0	1	V
工作温度	T_A	-55	+125	°C

原理图



真值表

输入		输出
ENA_N	AN	YN
L	L	L
L	H	H
H	×	Z

输入		输出
ENB_N	AM	YM
L	L	L
L	H	H
H	×	Z

注：H 表示高电平，L 表示低电平，X 为任意态,Z 为高阻态, N=1,2,3,4,M=5,6,7,8 没有信号输入时，使能端 ENA_N、ENB_N 默认为高电平，输入端 AN、AM,默认为低电平。